【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【公表番号】特表2004-524984(P2004-524984A)
【公表日】平成16年8月19日(2004.8.19)
【年通号数】公開・登録公報2004-032
【出願番号】特願2002-583317(P2002-583317)
【国際特許分類】
Ｂ８２Ｂ　3/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ８２Ｂ　3/00

【誤訳訂正書】
【提出日】平成19年11月15日(2007.11.15)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一次元ナノ構造を作製する方法であって：
－平行な原子ライン（４）をシリコンカーバイドの基板（２）の表面に形成する段階と、
－材料が、前記表面において、原子ライン間に選択的に吸着し、原子ライン上には吸着しないように堆積する段階と、を備え、
前記材料の堆積によって、原子ライン間の前記材料のストリップ（６，８）を形成し、
前記原子ライン（４）はシリコンから成る
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
シリコンカーバイドは立方構造を有し、その表面は立方シリコンカーバイド基板の（100）面である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記材料はパッシベートされたストリップ（６）を形成するように選択されている請求項１又は２のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
前記材料が水素である請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記材料が酸素、又はその下の表面をパッシベートすることが可能な他の分子である請求項３に記載の方法。
【請求項６】
前記材料は導電性ストリップ（８）を形成するように選択されている請求項１又は２のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
前記材料が金属である請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記金属がアルカリ金属及び遷移金属からなる群から選択されている請求項７に記載の方法。
【請求項９】

前記金属が銀、金、又は銅である請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
前記材料が有機分子である請求項１又は２のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
前記材料が無機分子である請求項１又は２のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法で得られたナノ構造。
【請求項１３】
前記材料が、ＮＯ、N_2O、N_2、NH_3及び硫黄からなる群から選択された少なくとも一つである請求項５に記載の方法。
【請求項１４】
前記有機分子が、ポリマー、ベンゼン分子、ペンタセン分子又は一次元有機分子からなる群から選択された少なくとも一つである請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
前記無機分子がハロゲン又は硫黄である請求項１１に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
このようなナノ構造を作製するために、シリコン基板２を、その表面がセルフオーガナイズ（自己構成）してc(4x2)表面となるように処理し、その結果、表面が平行なシリコン原子ライン４を備えるようにされたシリコン基板２（図参照）を用いる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
表面を、飽和するまで水素分子に曝す（50L以上）のが特徴である。この飽和に達しているか否かをSTMすなわち、Scanning Tunneling Microscopyで観察しながら、水素分子の曝露量を制御してもよい。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
表面が自己構成されるという特性を、シリコン原子の完全表面上にシリコン原子ラインを並べて形成するために利用する。これらのライン間の距離は、超高真空中でSiC基板の精密なアニーリング処理によって決定してもよい。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
カリウム原子源を超高真空チャンバに配備し、非常に精密に脱ガスを行う。カリウム原子の単層が蒸着される間に、チャンバーの圧力が$2x10^{-9}$Paを越えないときは、カリウム原

子源は十分に脱ガスされていると考えることができる。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
次いで、カリウム原子源をキャリブレートしなければならない。カリウム原子の蒸着速度を決定できるいかなる方法を用いてもよい。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
手順を以下に示す：
ａ）立方シリコンカーバイド（3c-SiC）のサンプルを$5x10^{-10}$hPaチャンバ内に配備し、650℃で数時間、次いで、1100℃で1分間を数回、この試料に直接電流を流すことによって加熱する。
ｂ）1300℃に加熱されたシリコン源を用いて、数層のシリコン層を立方SiCの(100)表面に堆積する。
ｃ）アニーリングを用いて、堆積されたシリコンの一部を、原子スケールの表面構造が3x2対称（再構成）となるまで蒸発するように制御する。この表面対称性を、電子回折の手法を用いて制御してもよい。
ｄ）この3x2表面は、完全にシリコン原子から成る表面上に並んだ極端に密なシリコン原子ラインから成る。さらなるアニーリング操作によって、制御されたやり方でこれらのラインの密度を低減することができる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
シリコン原子ラインを備えたSiC表面を、カリウム源から約3cmの距離に配備する。次いで、カリウム原子をSiC表面に堆積する。このカリウム原子はシリコン原子ライン間に堆積するのが好ましい。堆積されるべきカリウムの量は、ライン間のスペースを充填する量に対応しなければならない。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
一般的ルールとして、金属ナノストリップの作製は、以下の２つの特性を有する吸着物によって実施できる：
－吸着物がシリコンライン間に選択的に吸着されるという特性、
－吸着物がライン間のスペースを金属化（メタライズ）する（例えば、立方ＳｉＣのｃ（４ｘ２）型再構成の金属化）という特性。